

C20190312-[アプライド](#)・オプトエレクトロニクス、100G PIN PD チップ発売

Applied Optoelectronics, Inc. (AOI)は、高速光トランシーバ向けに波長あたり 100Gbps PIN フォトダイオード(PD)を発売した。

AOIのハイパフォーマンス 100Gbps InGaAs PIN PDsは、フロントサイド照射、高速グラウンド-シグナル-グラウンド(GSG)電気パッド構成が特徴。デバイスは、1270nm～1610nmの光通信帯域で動作するように設計されている。高帯域に加えて、同デバイスは、高応答性、低容量、低暗電流、最も要求の厳しいアプリケーション環境でも優れた信頼性を持つように設計されている。15 μ m 開口 100Gbps PIN PDは受信感度-9dBm OMA達成可能。これをAOIの100Gbps PAM4レーザとペアで用いると、100Gbps PIN PDは、100G DR、100G FR、400G DR4および400GFR4トランシーバなどのアプリケーションに最適となる。これらは、主に大規模データセンタオペレータがデータセンタ内のスイッチの相互接続に用いている。

AOIのR&D担当VP、Dr. Jun Zhengは「レーザダイオードとフォトダイオードは、光トランシーバの2つの重要アクティブコンポーネント。この新しい波長あたり 100Gbps PIN PDにより、AOIはこれら重要コンポーネントを社内工場で製造できるようになり、垂直統合を強化して、当社は100G、400G顧客に以前にも増して貢献できる」とコメントしている。

デバイスは現在サンプル出荷中。量産は、2019年第2四半期の予定。

([Applied Optoelectronics](#))